

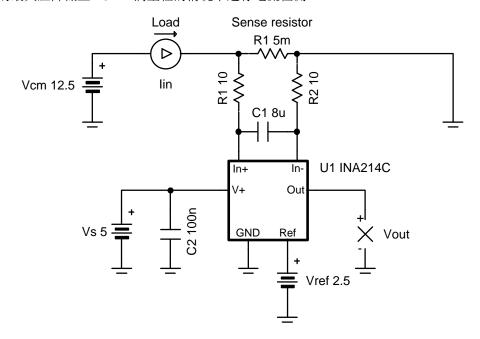
具有集成精密增益电阻器的低漂移低侧双向电流检测电路

设计目标

输入			输出		电源	
l _{inMin}	I _{inMax}	V_{cm}	V_{outMin}	V_{outMax}	V _s	V_{ref}
-4A	4A	12.5V	0.5V	4.5V	5V	2.5V

设计 说明

下图所示的低侧双向电流分流监控器解决方案可以精确测量 -4A 至 4A 的电流,并且可以轻松地针对不同的电流测量范围更改设计参数。INA21x 系列中的电流分流监控器集成了精密增益电阻器和零漂移架构,可在分流器上的最大压降低至 10mV 满量程的情况下进行电流检测。



设计说明

- 为了避免额外的误差,请使用 $R_1 = R_2$ 并保持电阻尽可能小(不超过 10Ω ,如《*INA21x* 电压输出、低侧或高侧测量、双向、零漂移系列电流分流监控器》中所述)
- 不应在系统负载 无法 承受小接地干扰的应用或需要检测负载短路的 应用 中使用低侧检测。
- 电流检测放大器入门 视频系列介绍了使用电流检测放大器时应了解的实现、误差源和高级主题。



设计步骤

1. 根据所需的电流范围确定 V_{ref}:

$$V_{ref} = \frac{1}{2}V_{s} = \frac{5}{2} = 2.5V$$

2. 根据最大电流和最大输出电压确定所需的分流电阻。

为了不超过相对于电源轨的摆幅并允许一些余量,应使用 V_{outMax} = 4.5 V_{outMax} 总与最大电流 4A 和在第 1步中计算的 V_{ref} 相结合,可以使用以下公式确定分流电阻:

$$R_1 = \frac{V_{outMax} - V_{ref}}{\square \square \times I_{loadMax}} = \frac{4.5 - 2.5}{100 \times 4} = 5 m\Omega$$

3. 确认 Vout 将处于所需的范围之内:

当最大电流为
$$4A$$
、增益 = $100V/V$ 、 $R_1 = 5m\Omega$ 且 $V_{ref} = 2.5V$ 时: $V_{out} = I_{load} \times Gain \times R_1 + V_{ref} = 4 \times 100 \times 0.005 + 2.5 = 4.5V$

当最小电流为
$$4A$$
、增益 = $100V/V$ 、 R_1 = $5m\Omega$ 且 V_{ref} = $2.5V$ 时: $V_{out} = I_{load} \times Gain \times R_1 + V_{ref} = -4 \times 100 \times 0.005 + 2.5 = 0.5V$

4. 滤波电容器选择:

为了对
$$1kHz$$
 的输入信号进行滤波,应使用 $R_1 = R_2 = 10\Omega$:

$$C_1 = \frac{1}{2\pi(R_1 + R_2)F_{-34B}} = \frac{1}{2\pi(10 + 10)1000} = 7.958 \times 10^{-6} \approx 8\mu F$$

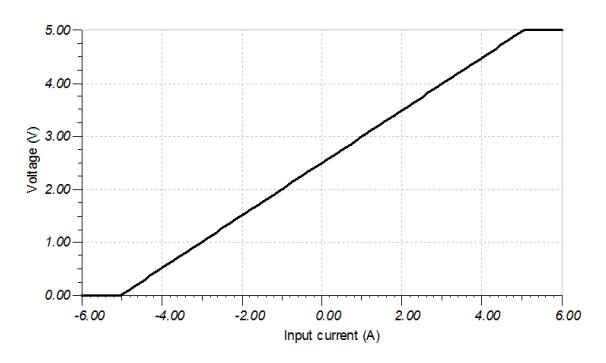
有关信号滤波和相关增益误差的更多信息,请参阅《INA21x 电压输出、低侧或高侧测量、双向、零漂移系列电流分流监控器》。



设计仿真

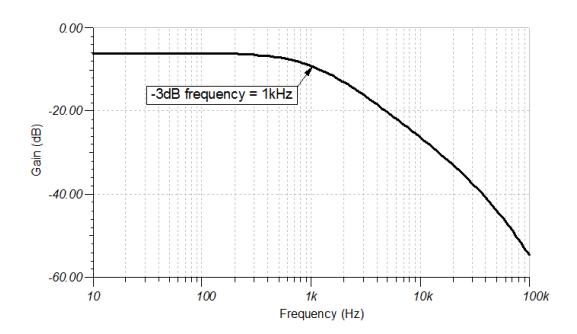
直流分析仿真结果

下图显示了给定输入电流 I_{in} 下的仿真输出电压 V_{out} 。



交流分析仿真结果

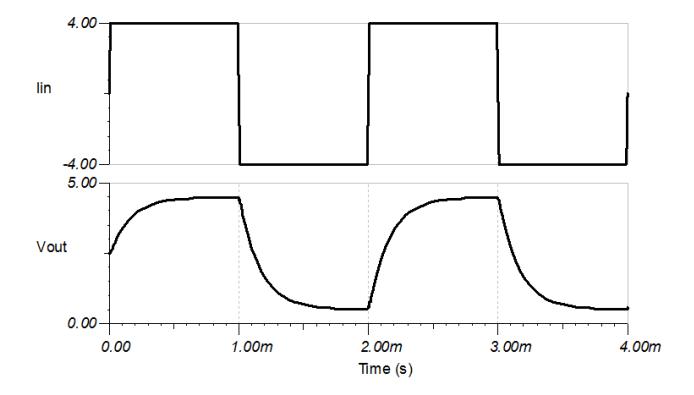
下图显示了仿真增益与频率间的关系(通过相关的设计步骤进行实现)。





瞬态分析仿真结果

下图显示了 -4A 至 4A I_{in} 中阶跃响应的输出 V_{out} 的仿真延迟和建立时间。





设计参考资料

请参阅《模拟工程师电路说明书》,了解有关 TI 综合电路库的信息。

电路 SPICE 仿真文件: http://proddms.itg.ti.com/fnview/sboc518

"电流检测放大器入门"视频系列: https://training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers

TI.com 上的电流检测放大器: http://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/products.html

如需 TI 工程师的直接支持,请使用 E2E 社区: http://e2echina.ti.com

设计采用的电流检测放大器

INA214C				
V _s	2.7V 至 26V			
V _{cm}	GND-0.1V 至 26V			
V _{out}	GND-0.3V 至 V _s +0.3V			
V _{os}	±1μV(典型值)			
I _q	65µA(典型值)			
I _b	28µA(典型值)			
http://www.ti.com.cn/product/cn/INA214				

设计备选电流检测放大器

INA199C				
V _s	2.7V 至 26V			
V _{cm}	GND-0.1V 至 26V			
V _{out}	GND-0.3V 至 V _s +0.3V			
V _{os}	±5µV(典型值)			
I _q	65µA(典型值)			
I _b	28µA(典型值)			
http://www.ti.com.cn/product/cn/INA199				

INA181				
V _s	2.7V 至 5.5V			
V _{cm}	GND-0.2V 至 26V			
V _{out}	GND-0.3V 至 V _s +0.3V			
V _{os}	±100μV(典型值)			
I _q	65µA(典型值)			
I _b	195µA(典型值)			
http://www.ti.com.cn/product/cn/INA181				

重要声明和免责声明

TI 均以"原样"提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1)针对您的应用选择合适的TI产品;(2)设计、验证并测试您的应用;(3)确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn/上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址: 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码: 200122 Copyright © 2019 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

重要声明和免责声明

TI 均以"原样"提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任: (1)针对您的应用选择合适的TI产品; (2)设计、验证并测试您的应用; (3)确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址: 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码: 200122 Copyright © 2019 德州仪器半导体技术(上海)有限公司